

第一章 PN 结

内容提要

□ 什么是 PN 结

□ 外加电压

□ 平衡态能带图

PN 结是其他微电子器件的基础。

PN 结的常见应用有：太阳能电池，GaAs / GaN 激光器，有机发光二极管，雪崩光电二极管，CMOS 图像传感器。OLED 是有机半导体的显示材料，怕水，寿命有限。

1.1 PN 结的形成

PN 结最早是通过热扩散，目前有沉积、扩散、激光掺杂等工艺。

一般掺杂得到的是二维的器件，电流方向不是直线，难以求解。若是得到的是一个很窄的器件，可以简化为一个一维问题，对第二个维度的依赖性会变低，只需考虑第一维度的运动情况。

两种半导体直接相连是不能得到 PN 结的，因为断面上的原子不能形成化学键。对 N 型半导体，费米能级靠近导带，对于 P 型半导体，靠近价带。在两个体区中，N 型中很多的施主杂质电离的正离子（无法移动），但是有等量的电子（可以移动， $n = N_D$ ）；类似的 P 型存在可以移动的空穴（ $p = N_A$ ）。浓度差造成了扩散，那么 N 型靠近结区的部分电子被中和，整体带正电，P 型对应部分带负电，这就是耗尽区。由于扩散的存在，出现 $n \cdot p > n_i^2$ 的瞬态。

电流分为两部分，漂移电流以及扩散电流。之前考虑的是扩散电流，因为此时还没有出现两部分的电势差。由于扩散后出现了静电荷，形成了电场，开始考虑漂移电流。电场逐渐增大，受到的阻力也越来越大，直到扩散电流与漂移电流相互抵消，进入稳态，即完成形成过程。

可以分为两个体区以及耗尽区（空间电荷区），耗尽区中没有自由移动的电荷，N 型一侧有 $n \ll n_0$ ，另一侧有 $p \ll p_0$ 。

$E_c(x)$ 如图 1.1

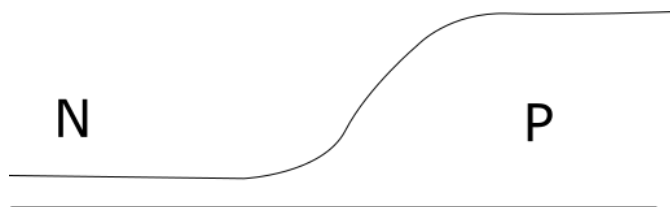


图 1.1: $E_c(x)$ 变化

$n(x)$ 满足

$$n(x) = N_c \exp\left(-\frac{E_c(x) - E_F}{kT}\right)$$

其中, $E_c - E_F \approx 0.06\text{eV}$, $kT \approx 26\text{meV}$ 。

依靠本式, 得到, 空间电荷区几乎没有自由电荷。最后的分布如图 ??

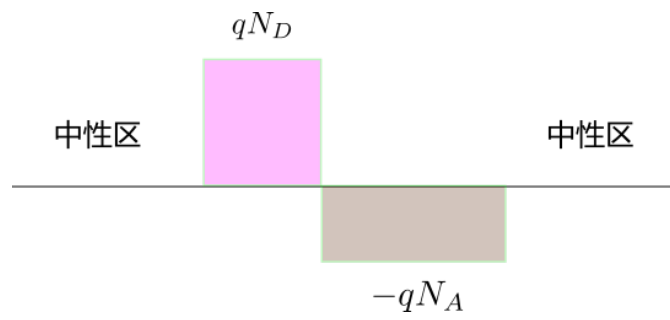


图 1.2: PN 结区域